557696

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 2. Dezember 2004 (02.12.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2004/104648 A1

(51) Internationale Patentklassifikation7:

G02B 5/00.

- G03B 9/06
- PCT/EP2004/005061 (21) Internationales Aktenzeichen:
- (22) Internationales Anmeldedatum:

12. Mai 2004 (12.05.2004)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

103 23 923.5

22. Mai 2003 (22.05.2003)

- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): CARL-ZEISS JENA GMBH [DE/DE]; Carl-Zeiss-Promenade 10, 07745 Jena (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BARTZKE, Karlheinz [DE/DE]; Gothaer Strasse 20, 99867 Gotha (DE).

- WOLLESCHENSKY, Ralf [DE/DE]; An der Promenade 3, 99510 Apolda (DE). SCHELER, Roland [DE/DE]; Rudolf-Breitscheid-Strasse 9, 07747 Jena (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

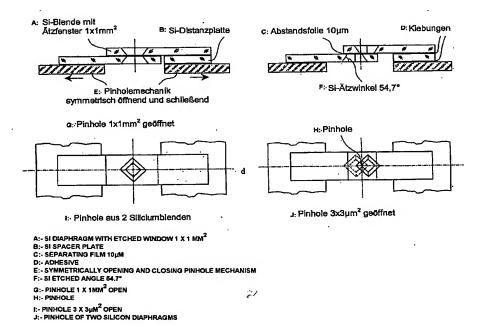
(74) Anwalt: HAMPE, Holger; Carl Zeiss Jena GmbH, Carl-

Zeiss-Promenade 10, 07745 Jena (DE).

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

- (54) Title: ADJUSTABLE PINHOLE IN PARTICULAR FOR A LASER-SCANNING MICROSCOPE
- (54) Bezeichnung: EINSTELLBARES PINHOLE, INSBESONDERE FÜR EIN LASER-SCANNING-MIKROSKOP



(57) Abstract: The invention relates to a pinhole, in particular, for a laser-scanning microscope, comprising silicon diaphragms, each with mirror-image right-angled openings, whereby the silicon diaphragms may be displaced in a first direction towards each other and preferably at least one silicon diaphragm may be displaced, perpendicular to the first direction, in a second direction, for adjustment of an exactly square form.

WO 2004/104648 A1

T INDIA BURNAN IN DIGINA KUBA BURNA BURNA BURNA BURNA IN DIGINAKA BURNA BURNA BURNA BURNA BURNA BURNA BURNA BURNA

GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht

Einstellbares Pinhole, insbesondere für ein Laser-Scanning-Mikroskop

Die geometrischen Parameter des Pinholes sind entscheidend für die Leistungsfähigkeit eines Laserscanmikroskopes. Je kleiner und genauer sich das Pinhole einstellen läßt, um so höhere Auflösungen des Laserscanmikroskopes sind erzielbar und um so kleinere Abmessungen der Mikroskopoptik sind möglich. Es bringt Vorteile, Pinholeöffnungen ab 3µm Größe einstellen zu können. Reproduzierbarkeiten von 0,3µm in der Einstellung der Pinholeöffnung und -lage sind dann gefordert. Noch kleinere Pinholeöffnungen bewirken zu große Intensitätsverluste durch Beugung des hindurchtretenden Lichtes an den Pinholekanten. Die Pinholeöffnung, die vorwiegend vor dem Photoempfänger angeordnet ist, muß nicht kreisförmig sein, sondern kann ebenso auch eine quadratische Form aufweisen.

Für einstellbare Pinholes in Laserscanmikroskopen werden Elemente verwendet, die, bevorzugt zur Erzeugung quadratischer Öffnungen, verstellbare gerade körperliche Kanten aufweisen. Damit diese Kanten möglichst scharf sind und hierdurch die Öffnung eine geringe Ausdehnung in Richtung des Lichtflusses aufweist, sind diese Elemente an den Kanten der Öffnung entweder angefast oder die Elemente sind dünne Folien. Der Stand der Fertigungstechnik ermöglicht Kanten, die Pinholes mit Ausdehnungen in Richtung des Lichtflusses von weit über 10µm zur Folge haben. Bei solchen Pinholes besteht jedoch die Gefahr der Vignettierung des Lichtes, wenn Öffnungen von kleiner als 10µm Größe eingestellt werden sollen.

So wird in der DE 202 05 079 UI eine variable Lochblende für ein konfokales Scanmikroskop beschrieben, die aus zwei diametral beweglichen Blendenbacken mit Einkerbungen besteht. Solche Einkerbungen sind nur begrenzt scharfkantig herstellbar, so daß solch ein Pinhole eine Ausdehnung in Richtung des Lichtflusses von ca. 100µm aufweist. Die Nachteile dieser Lösung sind die Gefahr der Vignettierung des Lichtes und die unvermeindlichen Rundungen der Ecken in den Einkerbungen. Beides führt dazu, daß quadratfömige Öffnungen von unter 10µm Größe nicht einstellbar sind. Ausreichend kleine Schrägstellungen des Pinholes, von z. B. weniger als 0,1°, lassen sich nur mit relativ hohem technischen Aufwand erzielen.

Das Ziel der Erfindung besteht darin, ein einstellbares Pinhole zu realisieren, daß Öffnungen ab 3µm Größe in einem Feld von 1x1mm² mit 0,3µm Toleranz ermöglicht. Hierbei ist es wichtig, die körperliche Ausdehnung der Öffnung in Richtung des Lichtflusses ausreichend klein zu halten, z. B. kleiner als 10µm, um Vignettierungen des die Öffnung passierenden Lichtes zu vermeiden.

1

Der Lösungsvorschlag besteht darin, für das Pinhole im Laserscanmikroskop zwei spiegelbildlich und zueinander verschieblich angeordnete Siliciumblenden mit je einem quadratischen Ätzfenster anzuwenden.

Ein Vorteil der Lösung bestehen darin, daß Silicium eine kubische Kristallstruktur aufweist und somit beim photolithographischen Ätzen quadratische Öffnungen entstehen, deren Kanten atomar scharfkantig sind. Außerdem weisen die Flanken der Öffnung einen spitzwinkligen Ätzwinkel von 54,7° auf, so daß durch die spiegelbildliche Anordnung von zwei Siliciumblenden Pinholes mit beliebig kleiner Öffnung und beliebig kleiner Ausdehnung in Richtung des Lichtflusses gebildet werden können.

Ein weiterer Vorteil besteht darin, daß mit Silicium als Blendenmaterial in einem gewissen visuellen Spektralbereich von etwa 500nm optisch weiche Blenden entstehen, weil Silicium in diesem Spektralbereich mit zunehmender Wellenlänge eine zunehmende Lichtdurchlässigkeit aufweist. Hierdurch werden in diesem begrenzten Wellenlängenbereich um 500nm Beugungserscheinungen an der Blende vermieden oder gemindert. Das führt zur Verminderung von Lichtverlusten im Laserscanmikroskop durch Beugung und zu größeren Lichtintensitäten auf dem Photoempfänger bei kleinen Pinholeöffnungen und somit zu einer höheren Empfindlichkeit des Laserscanmikroskopes in diesem Spektralbereich des Lichtes. Der Nachteil von Silicium, nämlich seine zunehmende Lichtdurchlässigkeit ab dem visuellen Rotbereich, kann durch eine Reflektions-oder Absorptionsbeschichtung seiner Oberfläche behoben werden.

Bild 1: Pinhole aus 2 Siliciumblenden

In Siliciumplatten, mit den äußeren Abmessungen von ca. 7x5x0,5mm², sind photolithographisch Fenster von 1x1mm² Größe geätzt. Die Siliciumblenden werden paarweise so zueinander angeordnet, daß die geätzten Fenster spiegelbildlich zueinander liegen. Die Befestigung der Siliciumblenden auf der Pinholemechanik erfolgt durch Kleben. Eine Distanzplatte dient der Einhaltung des erforderlichen Abstandes zwischen oberer Blende und Pinholemechanik. Eine Abstandsfolie, die zwischen den Blenden angeordnet ist, bewirkt eine Pinholehöhe von 10µm. Durch eine antiparallele Bewegung der beiden Elemente der Pinholemechanik lassen sich Pinholegrößen zwischen 0 und 1mm einstellen.

Die Bewegungsrichtung der Pinholemechanik ist hierbei antiparallel zu den Diagonalen d der Ätzfenster in den Siliciumplatten.

Eine Schutzbeschichtung der Si-Blenden soll verhindern, das Licht die Blende außerhalb der Öffnung passiert, weil Silicium für langwelliges Licht ab etwa 500nm Wellenlänge zunehmend transparent wird. Hierzu können die Siliciumblenden mit einer etwa 100nm dicken Chrom, Gold, Aluminium oder Silberschicht bedampft werden. Alle diese Schichten haben aber den Nachteil einer hohen Reflektivität, so daß durch Reflexion störendes Streulicht im Laserscanmikroskop entsteht.

Besser geeignet sind schwarze lichtabsorbierende Schutzschichten, wie sie z. B. durch spezielle Bedampfung aufgetragen werden können.

Wieder Erwarten kann auch ohne Beschichtung gearbeitet werden, vorteilhaft im Wellenlängenbereich bis 600nm.

Zur Jusstierung werden unter einem Mikroskop die Blenden bei kleiner Öffnung, von z. B. 10µm Größe, mit Hilfe von Manipulatoren justiert. Weil wegen der geringen Pinholehöhe nur eine Tiefenschärfe von 10µm vom Mikroskop gefordert zu werden braucht, können hochauflösende Mikroskope mit einer Apertur von z. B. A = 0,8 Anwendung finden. Bei herkömmlichen Pinholes ist das nicht möglich, weil das Mikroskop wegen der Pinholehöhe von 100µm dann eine entsprechend hohe Tiefenschärfe und kleine Apertur von z. B. A = 0,1 aufweisen muß.

Bild 2: Justierung der Siliciumblenden durch integrierte Motorantriebe

)

)

Elemente 1 und 2 sind in X-Richtung antiparallel verschiebbar und tragen die beiden Siliziumblenden, wobei mindestens eine Blende auf einem weiteren Element 3 gelagert ist, das senkrecht zur Verschieberichtung der Elemente 1 und 2 verschiebbar ist.

Element 3 ist an zwei Festkörpergelenken befestigt, die eine hohe Steifigkeit in Verschieberichtung der Elemente 1 und 2 und eine hohe Gelenkigkeit in Verschieberichtung des Elementes 3 aufweisen.

Die Verschiebung des Elementes 3 in Y-Richtung erfolgt mittels zweier von einem Motor angetriebenen Spindeln, wobei der Motor drehgesichert und verschieblich am Element 2 angeordnet ist. Die zwei Spindeln, die in je eine auf Element 2 und 3 befestigte Mutter eingreifen, weisen vorteilhaft unterschiedliche Steigungen auf, beispielsweise kann eine Differenzsteigung von 50μm vorliegen.

Die Siliciumblenden werden in vorjustierter Lage auf die Elemente 1 und 3 der Pinholemechanik aufgeklebt (Bild 2). Durch den in y-Richtung zwischen den Elementen 1

und 3 wirkenden Motorantrieb mit Differenzgewindespindeln und durch die Gelenkanordnung (z. B. Festkörperparallelfedergelenke) ist die Justierung und jederzeit auch die Nachjustierung der Siliciumblenden im Laserscanmikroskop mit einer Auflösung von z. B. 0,1µm möglich. Die Auflösung von 0,1µm ergibt sich aus der Differenzsteigung der Gewindespindeln von z. B. 50µm, aus dem Mikroschrittbetrieb des Schrittmotors von 16 Mirkoschritten pro Vollschritt und aus 20 Vollschritten pro Motorumdrehung. Bei der Justierung werden unter mikroskopischer Beobachtung die Elemente 1 und 2 antiparallel in x-Richtung und Element 3 in y-Richtung motorisch verstellt bis ein quadratisches Pinhole von z. B. 10 x 10µm² Größe entsteht. Die Pinholeöffnung ist nun in dieser aber auch in einer anderen Größe quadratisch, wenn Element 1 und 2 antiparallel in X-Richtung verschoben werden. Vorteilhaft läßt sich hierdurch jederzeit das Pinhole auch im Laserscanmikroskop nachjustieren, falls dort seine mikroskopische Beobachtung ermöglicht wird. Die Elemente 1 und 2 werden zur Einstellung der Pinholegröße durch einen nicht dargestellten scherenartigen Mechanismus antiparallel in x-Richtung bewegt.

Das Pinhole kann im Laserscanmikroskop jederzeit auch ohne seine mikroskopische Beobachtung nur unter Auswertung Signale des Photoempfänger der Laserscanmikroskopes zum Quadrat justiert werden. Hierzu werden durch einen motorgesteuerten Scanvorgang die Elemente 1, 2 und 3 so gestellt, daß bei möglichst kleiner Pinholeöffnung das auf den Photoempfänger fallende Licht eine maximale Intensität aufweist. Dann muß das Pinhole eine quadratische Form aufweisen. Hierzu wird bei schrittweise kleiner werdender Blendenöffnung (x-Trieb) die auf Element 3 befestigte Si-Blende mittels y-Trieb so gestellt, daß der Photoempfänger ein maximales Lichtsignal empfängt. Dieser Scanvorgang abwechselnd mittels der x- und y-Triebe wird solange wiederholt, bis das maximale Lichtsignal des Photoempfängers eine vorbestimmte minimale Größe erreicht hat, das einer Pinholegröße von z. B. 10µm entspricht. Nach diesem automatischen Justierprozeß weist die Pinholeöffnung in jeder Größe zwangsläufig eine quadratische Form auf.

Bild 3: Pinholefläche in Abhängigkeit von der Pinholedejustierung ylust

Wie aus der Kurvenschar in **Bild 3a** zu erkennen ist, ergibt sich auf Grund der quadratischen Abhängigkeit der Pinholefläche von der Pinholedejustierung bei $y_{just} = 0$ eine sehr geringe Empfindlichkeit des Photoempfängers bei der Verstellung in y-Richtung und bei einer Dejustierung von $y_{just} = b$ eine maximale Empfindlichkeit. Vorteilhaft kann deshalb die Flankenmethode Anwendung finden, bei der beim Scannen in y-Richtung an den beiden

symmetrischen Flanken je ein Meßpunkt bei hoher Empfindlichkeit bestimmt und durch Einstellung auf den Mittelwert zwischen beiden Flanken die quadratische Pinholeform gewonnen wird. Diese Justierung wird bei einer relativ großen Pinholeöffnung von z. B. 100µm begonnen und bei einer möglichst kleinen Pinholegröße von z. B. 10µm beendet. Das Ergebnis ist zwangsläufig die quadratische Pinholeöffnung bei jeder Pinholegröße. In Bild 3b sind Beispielwerte angegeben,

5

Patentansprüche

1.

Pinhole, insbesondere für ein Laser-Scanning-Mikroskop, bestehend aus Siliziumblenden mit jeweils rechtwinkligen spiegelverkehrten Öffnungen.

2.

Pinhole nach Anspruch 1, wobei die Siliciumblenden zueinander in einer ersten Richtung verschieblich sind.

3.

)

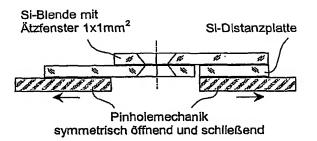
Pinhole nach Anspruch 2, wobei mindestens eine Siliziumblende senkrecht zur ersten Richtung in eine zweite Richtung zur Einstellung einer exakten Quadratform verschiebbar ist.

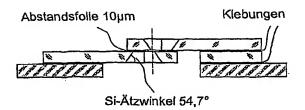
4.

Pinhole nach einem der Ansprüche 1-3, wobei die Blenden an Festkörpergelenken befestigt sind, die in der ersten Richtung steif und in der zweiten Richtung gelenkig ausgebildet sind.

5.

Verfahren zur Justierung eines Pinholes nach einem der vorangehendemn Ansprüche, wobei eine Quadratform eingestellt wird, indem bei der Justierung mittels einer durch das Pinhole gehende Lichtmenge das Signal eines Photoempfängers maximiert wird.





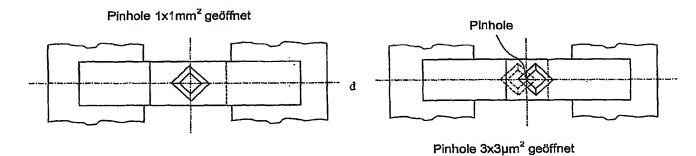
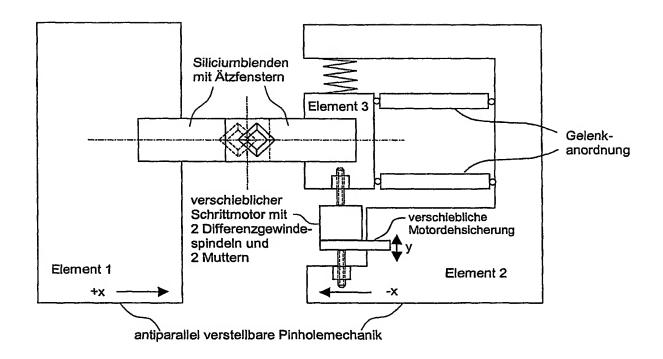
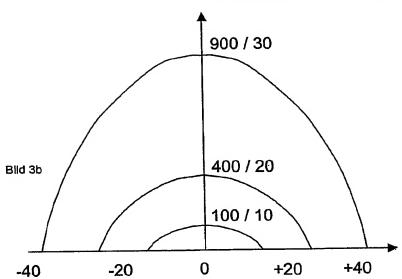


Bild 1: Pinhole aus 2 Siliciumblenden

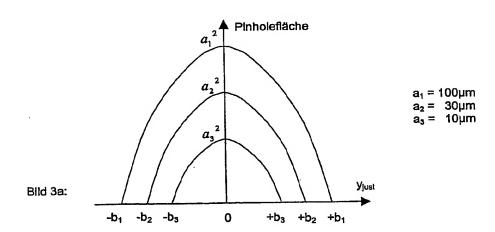
Bild2:



Pinholefläche in μm² / quadratische Pinholegröße in μm



Dejustlerung des Pinholequadrates zum Rechteck in µm



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

enternational Application No PCT/EP2004/005061

A. CLASSII IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER G02B5/00 G03B9/06				
According to	o International Patent Classification (IPC) or to both national classifica	tion and IPC			
B. FIELDS	SEARCHED				
Minimum do IPC 7	cumentation searched (classification system followed by classification $602B - 603B$	on symbols)	-		
Documentat	tion searched other than minimum documentation to the extent that s	uch documents are included in the fields searched			
Electronic da	ata base consulted during the International search (name of data bas	se and, where practical, search terms used)			
EPO-In	ternal, PAJ	•			
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category *	Cltation of document, with indication, where appropriate, of the rele	evant passages Relevant to claim	No.		
X	EP 0 565 069 A (FRAUNHOFER GES FORSCHUNG) 13 October 1993 (1993-10-13) column 5, line 35 - line 40 column 8, line 12 - line 15; figures 6-8				
Х	EP 0 280 375 A (STICHTING TECH WETENSCHAPP) 31 August 1988 (1988 abstract; figures 1-5	3-08-31)			
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1997, no. 10, 31 October 1997 (1997-10-31) -& JP 09 159935 A (OLYMPUS OPTICALTD), 20 June 1997 (1997-06-20) the whole document	1-5 AL CO			
Furl	ther documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed in annex.	1		
	ategories of cited documents : ent defining the general state of the art which is not	"T" later document published after the International filing date or priority date and not in conflict with the application but			
consid	dered to be of particular relevance document but published on or after the International	cited to understand the principle or theory underlying the invention. "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to			
L docume which	ent which may throw doubts on priority claim(s) or i is cited to establish the publication date of another on or other special reason (as specified)	involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the			
other	nent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means nent published prior to the international filing date but	document is combined with one or more other such docu- ments, such combination being obvious to a person skilled in the art.			
later t	than the priority date claimed actual completion of the international search	*&* document member of the same patent family Date of mailing of the International search report			
	21 July 2004	30/07/2004			
Name and	mailing address of the ISA	Authorized officer			
	European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk				
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016 Daffner, M				

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

international Application No PCT/EP2004/005061

Patent document clted in search report		Publication date	Patent family member(s)		Publication date
EP 0565069	A	13-10-1993	DE DE EP	4212077 A1 59303050 D1 0565069 A1	14-10-1993 01-08-1996 13-10-1993
EP 0280375	A	31-08-1988	NL AT DE EP GR JP US	8700496 A 64491 T 3863199 D1 0280375 A1 3002128 T3 63226864 A 4880294 A	16-09-1988 15-06-1991 18-07-1991 31-08-1988 30-12-1992 21-09-1988 14-11-1989
JP 09159935	Α	20-06-1997	NONE		

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

ternationales Aktenzeichen PCT/EP2004/005061

		' -	1, 2, 200 1, 000002		
A. KLASSIF IPK 7	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES G02B5/00 G03B9/06				
Nach der int	ernationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klass	sifikation und der IPK			
	RCHIERTE GEBIETE				
Recherchier	ter Mindestprüfstoff (Klassifikatlonssystem und Klassifikatlonssymbol G02B G03B	θ)			
Recherchier	te aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, sow	veit diese unter die recherch	ilerien Gebiele fallen		
Während de	r Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Na	ame der Datenbank und ev	I, verwendete Suchbegriffe)		
EPO-In	ternal, PAJ				
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN				
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	der in Betracht kommende	n Telle Betr. Anspruch Nr.		
X .	EP 0 565 069 A (FRAUNHOFER GES FO 13. Oktober 1993 (1993-10-13) Spalte 5, Zeile 35 - Zeile 40 Spalte 8, Zeile 12 - Zeile 15; Ab 6-8	•	1–5		
Χ .	EP 0 280 375 A (STICHTING TECH WETENSCHAPP) 31. August 1988 (198 Zusammenfassung; Abbildungen 1-5	8-08-31)	1-5		
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 1997, Nr. 10, 31. Oktober 1997 (1997-10-31) -& JP 09 159935 A (OLYMPUS OPTICA LTD), 20. Juni 1997 (1997-06-20) das ganze Dokument	L CO	1-5		
			·		
·			,		
	tere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anharig Pate	entfamilie		
"A" Veröffe aber n "E" älleres	ntlichung, die den allgemeinen Sland der Technik definiert, nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen	oder dem Prioritälsdatu Anmeldung nicht koliidi Erfindung zugrundelieg Theorie angegeben ist	g, die nach dem internationalen Anmeldedatum m veröffentlicht worden ist und mit der ert, sondern nur zum Verständnis des der enden Prinzips oder der ihr zugrundellegenden		
Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfinderscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund annegeben ist (wie					
soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) 'O' Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht 'P' Veröffentlichung, die vor dem Internationalen Anmeidedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist "A" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist					
	Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des Inte	ernationalen Recherchenberichts		
. 2	1. Juli 2004	30/07/200	4		
Name und I	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde	Bevollmächtigter Bedie	nsteter		
	Europālsches Patentami, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo ni, Fax: (+31–70) 340–3016	Daffner,	M		

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Verögungen, die zur selben Patentfamilie gehören

ternationales Aktenzeichen PCT/EP2004/005061

im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		Vitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0565069	Α	13-10-1993	DE DE EP	4212077 A1 59303050 D1 0565069 A1	14-10-1993 01-08-1996 13-10-1993
EP 0280375	A	31-08-1988	NL AT DE EP GR JP US	8700496 A 64491 T 3863199 D1 0280375 A1 3002128 T3 63226864 A 4880294 A	16-09-1988 15-06-1991 18-07-1991 31-08-1988 30-12-1992 21-09-1988 14-11-1989
JP 09159935	A	20-06-1997	KEINE		